

## 铟镓砷探测器 (InGaAs、DInGaAs)

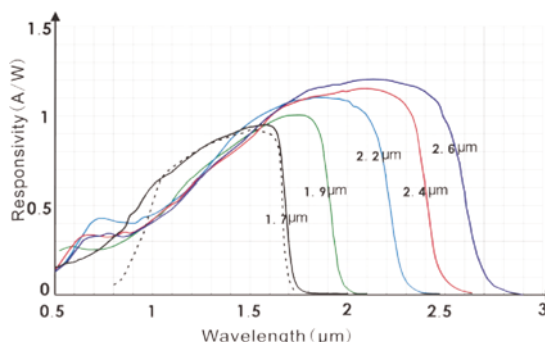
### 常温型铟镓砷探测器 (InGaAs)



- DInGaAs1650型内装国产大面积InGaAs元件;
- DInGaAs1700-R03M型内装进口InGaAs元件;
- DInGaAs2600-R03M型内装进口大面积InGaAs元件

#### 光谱响应度曲线参考图

(虚线为国产InGaAs元件光谱响应度曲线, 实线为进口元件):



#### 型号列表及主要技术指标:

型号/参数	DInGaAs1650	DInGaAs1700-R03M	DInGaAs2600-R03M
光敏面直径(mm)	3	3	3
波长范围(nm)	800-1700	800-1700	800-2600
峰值响应度(A/W, 最小)	0.85	0.9	1.1
暗电流(nA, 最大)	200	100	1mA
D*(典型值)	-	$2.3 \times 10^{12}$	$4.1 \times 10^{10}$
NEP(典型值)	-	$1.2 \times 10^{-13}$	$6.5 \times 10^{-12}$
阻抗(MΩ)	1	1.5	320Ω
电容(pF)	1500	800	9000
响应时间(ns)	160	100	1μs
信号输出模式	电流	电流	电流
输出信号极性	正(P)	正(P)	正(P)